



- (51) 国際特許分類:
C23C 18/02 (2006.01) G11B 5/84 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/050294
- (22) 国際出願日: 2009年1月13日 (13.01.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2008-018612 2008年1月30日 (30.01.2008) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): コニカミノルタオプト株式会社 (KONICA MINOLTA OPTO, INC.) [JP/JP]; 〒1928505 東京都八王子市石川町2970番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山田 基弘 (YAMADA, Motohiro) [JP/JP]; 〒1918511 東京都日野市さくら町1番地 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社内 Tokyo (JP). 河合 秀樹 (KAWAI, Hideki)

[JP/JP]; 〒1928505 東京都八王子市石川町2970番地 コニカミノルタオプト株式会社内 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,

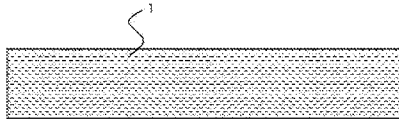
[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE MANUFACTURING METHOD

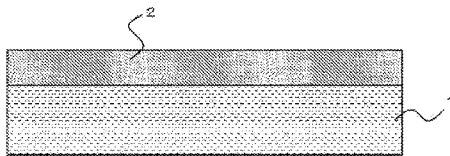
(54) 発明の名称: 基板製造方法

[図1]

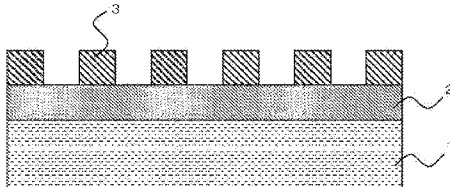
(a)



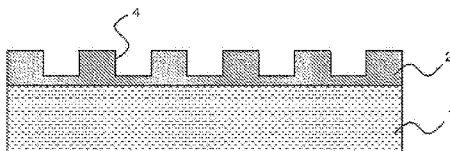
(b)



(c)



(d)



(57) Abstract: A glass board containing an impurity of 10[wt%] or more but not more than 50[wt%], a resin board, a metal board or a ceramic board is used as a board (1). An SiO₂ film (2) is formed on the board (1) by liquid phase deposition. An etching mask (3) having a prescribed pattern is formed on the SiO₂ film (2), and an uneven shape (4) is formed on the SiO₂ film (2) by dry-etching the SiO₂ film (2).

(57) 要約: 基板1には、10 [wt%] 以上50 [wt%] 以下の不純物を含むガラス基板、樹脂基板、金属基板、又はセラミック基板を用いる。その基板1に液相析出法によってSiO₂膜2を成膜する。SiO₂膜2上に所定のパターンを有するエッチングマスク3を形成し、SiO₂膜2をドライエッチングすることでSiO₂膜2に凹凸形状4を形成する。



SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書